



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W1XZ093D
整流二极管

文件编号	XS-R-131
版本号	18-A4-05
页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W1XZ093D 封装的成品管主要用于各类整流电路中。

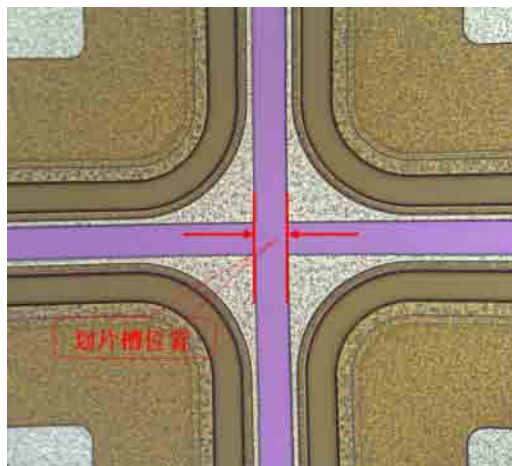
1.2 主要特点

- 低正向压降
- 低反向漏电
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.93×0.93		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	220±20		
	划片道*尺寸 (μm)	50		
	键合区面积 (μm ²)	正面	260×260	
	正面电极 (阳极)	金属	铝	
		厚度 (μm)	5.0±1.0	
	背面电极 (阴极)	表层金属	金	银
	装片要求 (推荐)	共晶	低温共晶	
	硅片直径 (mm)	φ 125		
	键合要求 (推荐)	铜丝; φ 32 μm; 两根		

* 划片道位置示意图:



3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}C$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	400	V	推荐封装形式: SOD-123 推荐产品: 2CZ4004
结温	T_j	150	$^{\circ}C$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}C$	

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W1XZ093D
整流二极管

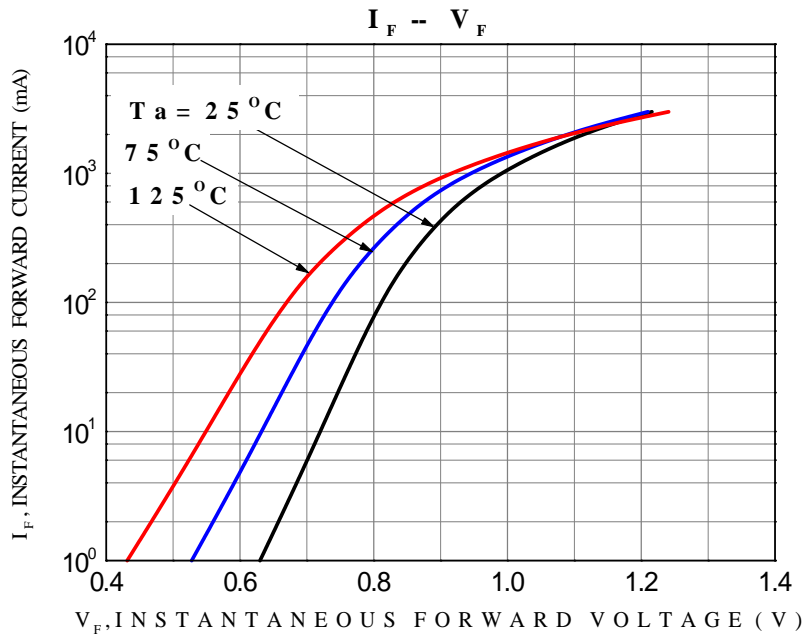
文件编号	XS-R-131
版本号	18-A4-05
页码	2/3

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	$V_{(BR)}$	$I_R = 10\mu\text{A}$	400	—	—	V
反向电流	I_R	$V_R = 400\text{V}$	—	—	0.2	μA
正向电压	V_F	$I_F = 1\text{A}$	—	—	1.1	V

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司

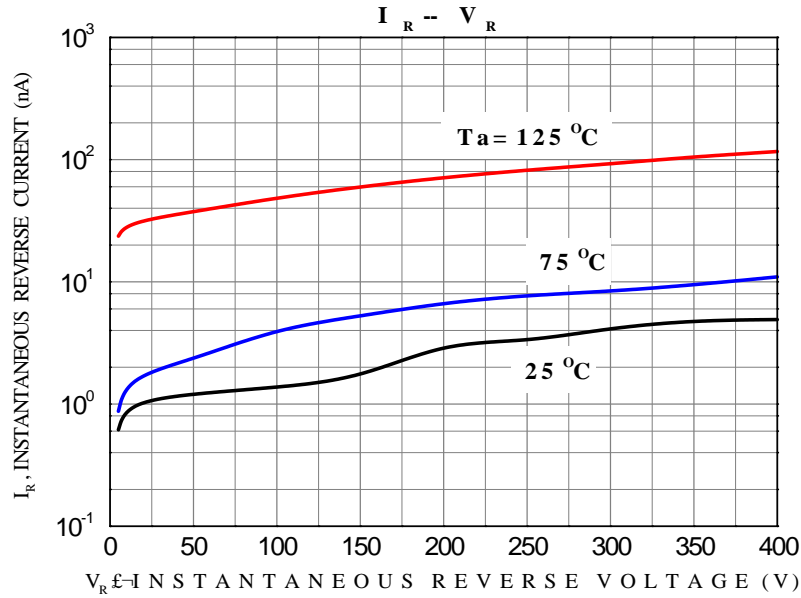
地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传真: (0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W1XZ093D
整流二极管

文件编号	XS-R-131
版本号	18-A4-05
页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电话：(0510) 86851182

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传真：(0510) 86851532